

---

ПАМ'ЯТІ ЄВГЕНА АНДРІЙОВИЧА САЛЬКОВА

---



15 жовтня 2011 р. на 84 році пішов із життя Євген Андрійович Сальков, доктор фізико-математичних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Є.А. Сальков народився на Харківщині. В 1955 році закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка і почав працювати у відділі напівпровідників Інституту фізики АН України під керівництвом академіка В.Є. Лашкарьова.

В Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Є.А. Сальков працював з дня його заснування. За цей час він пройшов шлях від інженера до відомого вченого та організатора науки, якого добре знають в Україні та далеко поза її межами. Довгий час Є.А. Сальков працював на посаді заступника директора Інституту (1967–1978 рр.), з

1978 р. по 1991 р. він завідував галузевим відділенням напівпровідникової фотоелектроніки, до 1997 року був завідувачем відділу фізичних проблем інфрачервоної сенсорики, а з квітня 1997 року Є.А. Сальков працював головним науковим співробітником відділу фізико-технічних проблем надійності матеріалів і процесів.

Є.А. Сальковим було отримано цілу низку визначних результатів у галузі фізики твердого тіла та фізики напівпровідників. Ним вперше було розроблено феноменологічну теорію нерівноважних процесів за участі екситонів, введено нові уявлення про міжцентрові електронні переходи, визначено механізми дефектоутворення в напівпровідникових кристалах в процесі руху дислокацій.

Особливо плідно Є.А. Сальков працював впродовж 1978–1991 рр., коли він очолював ним же організоване при ІФН НАН України Відділення напівпровідникової фотоелектроніки, що фінансувалося Міноборонпромом СРСР. Робота відділення була відзначена чотирма Державними преміями УРСР, дві з них за участі Є.А. Салькова (1981 та 1986 рр.). При цьому було виконано комплексні дослідження найважливіших матеріалів ГЧ-фотоелектроніки, організовано в Україні виробництво елементної бази ГЧ-фотоелектроніки подвійного (військового та цивільного) призначення, впроваджено наукові основи промислової метрології напівпровідників для ГЧ-техніки. Активну участь Є.А. Сальков брав і в роботах з розробки електронних засобів бачення у широкому діапазоні спектра випромінювання, включаючи в себе засоби теплобачення і термографії.

В останні роки Є.А. Сальков продовжував успішну роботу в напрямку детектування та ідентифікації ГЧ-випромінювання малих об'єктів атмосферного та космічного походження, а також дослідження флуктуаційних явищ у напівпровідниках. Його праці опубліковано у престижних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Є.А. Сальковим створено наукову школу, представниками якої є 6 докторів і більше 20 кандидатів наук. Науковий доробок Є.А. Салькова становить понад 200 публікацій (в тому числі 2 монографії) та 54 авторські свідоцтва на винаходи СРСР і України.

Є.А. Салькову були притаманні кращі людські риси: душевна щедрість, порядність, відповідальність за доручену справу, вроджений талант керівника,

оптимізм та незмінне почуття гумору. Ці якості разом з високими громадянськими почуттями і бездоганною науковою репутацією завоювали Є.А. Салькову загальну повагу і любов. Євген Андрійович Сальков надовго залишиться в пам'яті всіх, хто його знав.

*В.Ф. Мачулін, В.Г. Литовченко,  
співробітники Інституту, друзі, колеги*